



美光 HBM4 已向主要客户出货，驱动下一代 AI 平台落地

美光 12 层堆叠 36GB HBM4 能效领先业界，实现数据中心和云端 AI 加速

2025 年 6 月 12 日，爱达荷州博伊西市——随着数据中心对 AI 训练与推理工作负载需求的持续增长，高性能内存的重要性达到历史新高。Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU）今日宣布已向多家主要客户送样其 12 层堆叠 36GB HBM4 内存。这一里程碑再次扩大了美光在 AI 内存性能和能效方面的领导地位。凭借其成熟的 1β（1-beta）DRAM 制程、经过验证的 12 层先进封装技术及功能强大的内存内建自测试（MBIST）功能，美光 HBM4 为开发下一代 AI 平台的客户及合作伙伴提供了无缝集成的解决方案。

重要飞跃

随着生成式 AI 应用的不断增长，高效管理推理能力的重要性与日俱增。美光 HBM4 内存具备 2048 位元接口，每个内存堆叠的传输速率超过 2.0 TB/s，性能较前一代产品提升超 60%¹。这样的扩展接口有助于实现高速通信与高吞吐量设计，进而提高大型语言模型和思维链推理系统的推理性能。简而言之，HBM4 将使 AI 加速器响应更迅速、推理更高效。

此外，延续美光前一代 HBM3E 内存²曾在业界树立的 HBM 能效新标杆，HBM4 的能效再度提升超 20%，展现了美光更进一步的技术突破。这项进展能以最低功耗提供更大吞吐量，从而更大幅度地提高数据中心的效率²。

随着生成式 AI 应用场景的持续扩展，此颠覆性技术将为社会创造显著价值。HBM4 是加速洞察与创新突破的关键推动力，能够促进医疗保健、金融和交通运输等不同领域的进步与变革。

美光高级副总裁暨云端存储事业部总经理 Raj Narasimhan 表示：“美光 HBM4 具备卓越的性能、更高的带宽和业界领先的能效，印证了美光在内存技术和产品方面的领导地位。基于此前 HBM3E 部署所取得的瞩目成就，我们将继续通过 HBM4 及强大的 AI 内存和存储解决方案组合引领创新。我们的 HBM4 生产进程与客户下一代 AI 平台的准备进度紧密配合，以确保无缝集成与适时扩大产量，满足市场需求。”

加速智慧革新：美光在 AI 革命中的关键作用

¹ 基于美光内部 HBM4 测试结果和已发布的 HBM3E 内存规格（2.0 TB/s 对比 1.2 TB/s 的带宽）。

² 根据美光内部模拟预测，以美光 12 层堆叠 36GB HBM3E 内存和类似竞争产品进行的比较。

近五十年来，美光不断突破内存和存储创新的边界。如今，美光持续通过提供广泛多元的解决方案，将数据转化为智慧，推动从数据中心到端侧设备的突破，进而加速 AI 发展。凭借 HBM4，美光再次巩固了其作为 AI 创新领域关键推手的地位，并成为客户应对严苛解决方案的可靠合作伙伴。

美光 HBM4 预计将于 2026 年量产，以配合客户下一代 AI 平台的扩产进度。如需了解更多关于美光 HBM4 的信息，请访问 <https://www.micron.cn/products/memory/hbm>。

更多资源：

- [HBM4 产品渲染图](#)

关于 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）

美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商，致力于通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。我们专注不懈地致力于满足客户需求，发展先驱技术，制造出众产品和实现卓越运营。凭借旗下全球性品牌 Micron®（美光）和 Crucial®（英睿达），向客户交付一系列丰富的高性能内存和存储产品组合——包括 DRAM、NAND 及 NOR。美光优秀人才打造的创新产品，每一天都助力数据经济的发展，促进人工智能（AI）和计算密集型应用的进步，带来无限潜能——从数据中心到智能边缘，以及丰富客户和移动用户的体验。如需了解 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU）的更多信息，请访问 micron.cn

© 2025 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）保留所有权利。信息、产品和/或规格如有变更，恕不另行通知。Micron、Micron 徽标和所有其他 Micron 商标均为 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）所属商标。所有其他商标分别为其各自所有者所有。

微信订阅号：



微信视频号：



美光媒体联络人

高诚公关

潘平 / 美光服务团队

电话：+86 188 8388 2632

E-mail: ppan@golin.com